

## P189 تحلیل جدید نیم میکروسکوپیکی پاشندگی بر خورد های هسته -

### هسته ای بر اساس پتانسیل فولدینگ

عبدالمجید ایزدپناه<sup>\*1</sup>، مرضیه یوسفی<sup>2</sup>

1. دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک

2. دانشگاه پیام نور، فریمان، گروه فیزیک

#### چکیده:

با استفاده از مدل نیم میکروسکوپیکی پاشندگی در چارچوب رهیافت پتانسیلی به توصیف برهمکنش هسته با هسته ها در بازه انرژی از چند تا صد MeV بر نوکلئون میپردازیم. محاسبه میکروسکوپی مولفه استاتیکی پتانسیل بدست آمده بر اساس پتانسیل فولدینگ را به عنوان داده های ورودی به کار برده و با ترکیب رهیافت پدیده شناختی برای محاسبه مولفه دینامیکی پتانسیل و رهیافت میکروسکوپیکی برای محاسبه مولفه استاتیکی پتانسیل، پارامترهای پتانسیل (تابع وود-ساکسون) را بدست آورده ایم.

**کلید واژه ها:** رهیافت نیم میکروسکوپیکی، پتانسیل موثر، پتانسیل میدان میانگین، پتانسیل قطبش دینامیکی.